

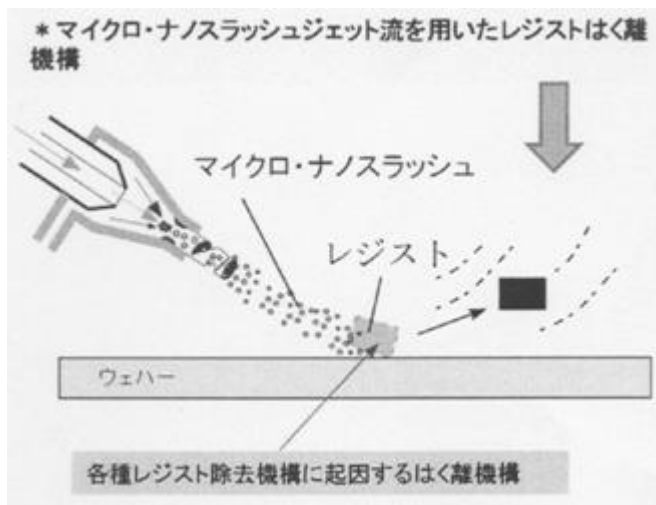
マイクロ・ナノスラッシュ利用型半導体洗浄システム

アッシングプロセス、洗浄工程が同時に可能です。

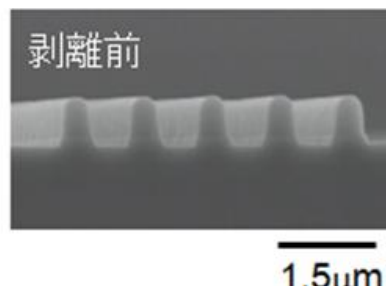
概要

現在、半導体洗浄のレジストを除去するアッシングプロセスにおいて、酸素プラズマでは除去しきれなかった細かいレジストを除去するために、コストが高くかつ人体に極めて有害な薬液（高純度の塩酸、フッ酸、硫酸、アンモニアなど）が使用されているのが現状である。

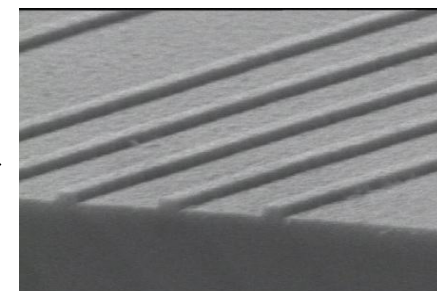
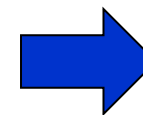
本発明は、アッシングプロセスとその後の洗浄工程を同時に行う事、また、純水及び薬品を使用せずドライ型である事の特徴としており、半導体洗浄の短縮化が期待できる。



【図1】スラッシュ噴霧によるレジストはく離の模式図



Resist (500nm)/
Poly-Si (150nm)/
SiO₂ (6nm)/ Si



【図2】スラッシュ噴霧によるレジストはく離効果の予備実験の結果

応用例

・半導体洗浄機器

特許データシート

特許番号(整理番号): 特願2010-011195(T09-096)
発明者: 石本 淳

連絡先

株式会社 東北テクノアーチ

TEL 022-222-3049 FAX 022-222-3419

お問い合わせは、[こちら](#) からお願い致します。